



产品特点

高精度MEMS工艺制备

高性能, 低温漂, 小体积

陶瓷基板, 50Ω共面波导

金丝键合, 适用于多芯片集成模块

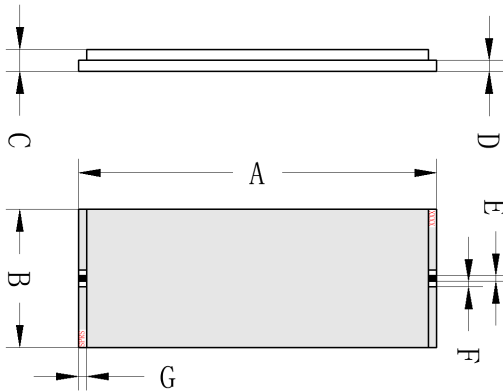
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.45	GHz
工作带宽	4.25-4.65	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	1.2	ns
带外抑制	40@DC-3.8GHz	dBc
带外抑制	40@5.1-12.5GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:7.0, B:6.5, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.72

外形图：端口居中



推荐装配图

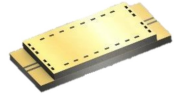


电路板Rogers5880, h:0.254mm	电路板Rogers5880, h:0.127mm
适用频率: 10-40GHz	适用频率: 10-70GHz

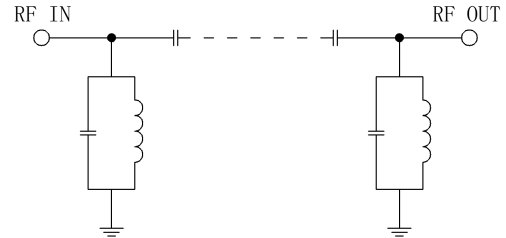
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.2mm, 端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接, 采用不少于2根25-50um金丝键合线连接, 连接线尽量短, 键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料, 载体厚度≥0.2mm,, 不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

参考实物图



原理图



典型曲线

